госсинские патенты. Текет документа

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выбор баз
данных
Параметры
поиска
Формулировка
запроса
Уточненный
запрос
Найденные
документы
Корзина
Сохраненные
запросы
Статистика
Помощь
Предложения
Выход

(0 y.e.)

(43872 руб.)

Реферат Рисунок

Статус по данным на 25.07.2008 - прекратил действие

(11) Номер публикации 2204179 (13) Вил локумента C1

(13) Вид документа C1
(14) Дата публикации 2003 05 10 Пеме

(14) Дата публикации 2003.05.10 Поческі (19) Страна публикации RU

(21) Заявка 2002121964/28

(22) Дата подачи заявки 2002.08.19

— (24) Дата начала отсчета срока 2002.08.19 действия патента

У Вас осталось 4387 запросов (45) Опубликовано

(45) Опубликовано 2003.05.10 Пемскі (516) Номер редакции МПК 7

(51) Основной индекс МПК H01L21/265

Название METHOD FOR SHAPING NANOTOPOGRAPHY ON FILM

SURFACE

(71) Заявитель(и) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennosť iu "Agentstvo

marketinga nauchnykh

razrabotok" Flosics

(72) Автор(ы) Smirnov V.K.

(72) Автор(ы) Kibalov D.S.

(73) Патентообладатель(и) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennosť ju "Agentstvo

marketinga nauchnykh

razrabotok" Flouck

Адрес для переписки 111250, Moskva, ul.

Aviamotornaja, 53, ZAO

"Patentnyj poverennyj", pat. pov.

G.N. Andrushchak, reg.№ 189

ДОКУМЕНТ
в начало
в конец
в корзину
печать
ТЕРМИНЫ
предыдущий
следующий



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выбор баз данных Параметры поиска Формулировка запроса Уточненный запрос Найденные документы Корзина Сохраненные запросы Статистика Помощь Предложения Выход

У Вас осталось 4387 запросов (0 у.е.) (43872 руб.) Библиография Рисунск №2204179. Реферат

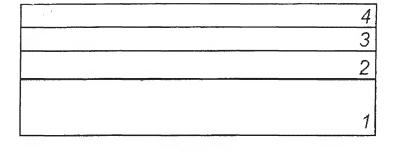
FIELD: microelectronics engineering. SUBSTANCE: method involves covering film surface with silicon layer whose thickness equals one and a half to three depths of nanostructure formation in silicon layer; spraying silicon surface with stream of nitrogen molecule ions in vacuum, nitrogen ion energy, nitrogen ion angle of flow relative to silicon

vacuum, nitrogen ion energy, nitrogen ion angle of flow relative to silicon surface, depth of nanostructure formation and nanostructure height being chosen basing on nanostructure wavelength ranging between 30 and 180 nm before formation of nanostructure spaced apart from film at one third of wavelength on nanostructure wave valleys with wave crest positioned perpendicular to projection of ion flow on silicon surface; transferring nanostructure topography to film surface with nanostructure and film materials being removed by ion-beam or plasma etching.

EFFECT: improved formation of nanotopography on film surface. 9 cl, 16 dwg



ДОКУМЕНТ
в начало
в конец
в корзину
печать



Фиг. 1